(19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(11)特許出顧公開番号

特開平8-204322

(43)公開日 平成8年(1996)8月9日

(51) Int.Cl.8

H05K 3/34

庁内整理番号 識別記号

505 C 7128-4E

502 Z 7128-4E

507 Z 7128-4E

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平7-10927

(22)出願日

平成7年(1995) 1月26日

(71)出顧人 000000158

イビデン株式会社

岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

(72)発明者 脇原 義範

岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1の1 イビデ

ン 株式会社大垣北工場内

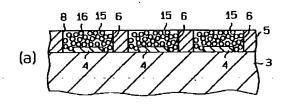
(74)代理人 弁理士 恩田 博宜

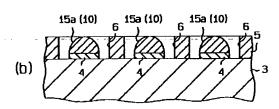
(54) 【発明の名称】 パンプの形成方法

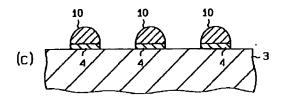
(57)【要約】

【目的】 所望形状のバンプを安価にかつ容易に形成で きるバンプの形成方法を提供すること。

【構成】 まず、開口部6を有するメタルマスク5を基 板3に重ね合わせる。メタルマスク5の開口部6は、基 板3表面の導体部分であるパッド4に対応する位置に形 成されている。次に、重ね合わせた状態でクリームはん だ7を印刷した後、リフローによってクリームはんだ7 を溶融させる。次に、メタルマスクラを基板3から取り 去る。すると、パッド4上に所望形状のはんだバンプ1 0が形成される。







【特許請求の範囲】

【請求項1】基板表面の導体部分にバンプを形成する方 法であって、前記導体部分に対応する位置に開口部を有 するメタルマスクを前記基板に重ね合わせる工程と、こ の状態で平均粒径が20μm以下のはんだ粉を含むクリ ームはんだを印刷する工程と、前記メタルマスクを前記 基板から取り去る工程と、リフローによって前記クリー ムはんだを溶融させる工程とからなるバンプの形成方 法。

【請求項2】基板表面の導体部分にバンプを形成する方 10 法であって、前記導体部分に対応する位置に開口部を有 するメタルマスクを前記基板に重ね合わせる工程と、こ の状態でクリームはんだを印刷し、かつリフローによっ て前記クリームはんだを溶融させる工程と、前記メタル マスクを前記基板から取り去る工程とからなるパンプの 形成方法。

【請求項3】前記クリームはんだの印刷・リフロー工程 は2回以上行われ、先に行われる印刷・リフロー工程で 使用されるクリームはんだは、後に行われる印刷・リフ ロー工程で使用されるクリームはんだよりも融点が高い 20 請求項1または2に記載のバンプの形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、バンプの形成方法に係 り、特にはフリップチップ実装用基板の表面に形成され た導体部分に対するバンプの形成方法に関するものであ る。

[0002]

【従来の技術】近年、基板に半導体チップを実装する方 式の一態様として、ベアチップを直接基板上に実装す る、いわゆるチップオンボード (COB) 方式が知られ ている。また、COB方式を採るときのチップ側と基板 側との電気的な接続方法の一種として、例えばフリップ チップ (CCB) 等が実施されている。CCBとは、概 して基板側の導体部分とチップ側の導体部分とをはんだ 等からなるバンプを介して電気的に接続するという方法 である。この方法によると、チップの裏面全体が接続用 の領域として利用可能になるため、チップの多端子化に 有利である。そして、このようなCCBの利点を生かし。 する要求が次第に高まってきている。

【0003】また、基板側の導体部分にはんだバンプを 形成する方法としては、例えば次の2つの方法がある。 第1の方法は、めっきレジストが形成された基板をめっ き液に浸漬し、導体部分に電解めっきまたは無電解めっ きを析出させる方法(めっき法)である。第2の方法 は、基板側の導体部分に対してディスペンサ等によって 溶融はんだを供給する方法(いわゆるソルダーインジェ クション法) である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記のめっ き法及びソルダーインジェクション法には、以下のよう

な問題点がある。

することが難しい。

【0005】電解めっき法の場合、基板にめっきリード 用のパターンを引き回す必要があるため、その分だけ基 板の大型化や高コスト化につながってしまう。無電解め っき法の場合、はんだを正確な組成で析出させることが 容易でなく、そのためには熟練を必要とする。また、無 電解めっき法であると、めっきの析出に時間がかかる。 さらに、これらのめっき法は基本的に化学的プロセスで あることから、めっき温度やめっき時間等の条件を設定

【0006】ソルダーインジェクション法の場合、溶融 はんだを供給するための高価な装置が必要であるため、 設備コストが高くなる。本発明は上記の課題を解消する ためになされたものであり、その目的は、所望形状のバ ンプを安価にかつ容易に形成することができるバンプの 形成方法を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた めに、請求項1に記載の発明は、基板表面の導体部分に バンプを形成する方法であって、前記導体部分に対応す る位置に開口部を有するメタルマスクを前記基板に重ね 合わせる工程と、この状態で平均粒径が20 m以下の はんだ粉を含むクリームはんだを印刷する工程と、前記 メタルマスクを前記基板から取り去る工程と、リフロー によって前記クリームはんだを溶融させる工程とからな るバンプの形成方法をその要旨とする。

【0008】請求項2に記載の発明は、基板表面の導体 30 部分にバンプを形成する方法であって、前記導体部分に 対応する位置に開口部を有するメタルマスクを前記基板 に重ね合わせる工程と、この状態でクリームはんだを印 刷し、かつリフローによって前記クリームはんだを溶融 させる工程と、前記メタルマスクを前記基板から取り去 る工程とからなるバンプの形成方法をその要旨とする。 【0009】請求項3に記載の発明は、請求項1または 2において、前記クリームはんだの印刷・リフロー工程 は2回以上行われ、先に行われる印刷・リフロー工程で 使用されるクリームはんだは、後に行われる印刷・リフ て、各種電子部品の高密度化や高集積化等を達成せんと 40 ロー工程で使用されるクリームはんだよりも融点が高い としている。

[0010]

【作用】請求項1に記載の発明によると、基板にメタル マスクを重ね合わせた状態でクリームはんだを印刷する と、メタルマスクの開口部を介してクリームはんだが供 給されることによって、導体部分の上面にクリームはん だが転写される。次に、基板からメタルマスクを取り去 ると、転写されたクリームはんだがメタルマスクから版 抜けする。次に、リフローによって基板を所定温度に加 50 熱すると、クリームはんだが溶融し、導体部分にはんだ

バンプが形成される。また、平均粒径が20μm以下の はんだ粉を含むクリームはんだが使用されているため、 メタルマスクからクリームはんだが容易に版抜けする。 【0011】請求項2に記載の発明によると、基板にメ タルマスクを重ね合わせた状態でクリームはんだを印刷 すると、メタルマスクの開口部を介してクリームはんだ が供給されることによって、導体部分の上面にクリーム はんだが転写される。次に、重ね合わせたままの状態で のリフローによって基板を所定温度に加熱すると、クリ ームはんだが溶融し、導体部分にはんだバンプが形成さ 10 れる。この後、基板からメタルマスクが取り去られる。 【0012】請求項3に記載の発明によると、先に行わ れる印刷・リフロー工程で使用されるクリームはんだ は、相対的に融点が高いため、後に行われる印刷・リフ ロー工程で加熱されても溶融することはない。従って、 積層構造のバンプが容易に形成される。

[0013]

【実施例】

〔実施例1〕以下、本発明をセラミックス基板上にベア チップを実装するためのはんだバンプの形成方法に具体 20 化した一実施例を図1~図5に基づき詳細に説明する。 【0014】図5 (d)に示されるように、被実装物で あるペアチップ1は、その裏面全体に複数の外部接続端 子2を備えている。一方、セラミックス基板3の表面に おけるベアチップ実装領域R1 には、導体部分としての 円形状のパッド4が形成されている。パッド4の形成材 料は銅であり、その直径は50μmである。また、前記 パッド4の位置は、各外部接続端子2の位置に対応して

【0015】クリームはんだ7の印刷に使用されるメタ 30 ルマスク5は、図1に示されるように、各パッド4に対 応する位置に円形状の開口部6を備えている。このメタ ルマスク5の厚さは50μm~200μmである。 開口 部6の内径は、前記パッド4の直径よりもひとまわり大 きく、60µm~120µmである。通常、クリームは んだ7の印刷量は、メタルマスク5の厚さと開口部6の 面積との積の値になる。本実施例では、メタルマスクラ をステンレス製とし、その板厚を100μmに設定して いる。また、開口部6の内径を80μmに設定してい る.

【0016】また、本実施例では、Pb/Sn系のクリ ームはんだ (いわゆる共晶はんだ、Pb/Sn=37/ 63, 溶融温度183℃) 7が使用される。 クリームは んだ7とは、粘ちゅうなベヒクル8の中に微細なはんだ 粉9を混ぜ合わせたものをいう。ベヒクル8にはフラッ クス作用をもつ材料が含まれており、この材料によって はんだの流動性がコントロールされる。なお、この実施 例においては、平均粒径が5μm~20μm程度のはん だ粉9が前記ベヒクル8中に混合されている。 通常の (平均粒径が $20\mu m\sim 60\mu m$ 程度の) ものよりも微 50 を容易に得ることができる。また、基板3にめっきリー

細なはんだ粉9を使用した理由は、クリームはんだ7の 版抜け性を向上させるためである。つまり、はんだ粉9 が微細であると、転写されたパターンが緻密になること によって版抜け時に形崩れしにくくなるからである。

【0017】次に、はんだバンプ10を形成する方法を 工程順に説明する。まず、基板3をスクリーン印刷機に セットした後、基板3の表面にメタルマスク5を重ね合 わせる(マスク配置工程)。その際、各開口部6の位置 と各パッド4の位置とを一致させる。

【0018】次の印刷工程では、図1. 図5 (a) に示 されるように、メタルマスク5の上部に配置されたスキ ージ11でクリームはんだ7を押し込むことによって、 クリームはんだ7を印刷する。 すると 、 開口部6を介し てクリームはんだ7が供給され、各パッド4の上面にク リームはんだ7が転写される。

【0019】次のマスク除去工程では、メタルマスク5 を垂直方向に移動させることによって、基板3からメタ ルマスク5を静かに取り去る。すると、図2,図5

(b) に示されるように、 転写されたクリームはんだ? がメタルマスク5の開口部6から版抜けする。そして、 円盤状ないし円柱状をした転写パターン12が基板3上 に残る。

【0020】次のリフロー工程では、基板3をリフロー 炉に移した後、基板3を所定温度(即ち、このはんだク リーム7のはんだ合金の溶融温度である183℃)に加 熱する。すると、クリームはんだ7が溶融し、図3.図 5 (c) に示されるように、溶融したはんだ7aがパッ ド4の上面に凝集する。このとき、溶融したはんだ7a の体積は、リフローの熱でベヒクル8が蒸発することに よって、当初の体積の約半分になる。そして、この溶融 したはんだ7aを冷却することにより、パッド4上に所 望形状 (本実施例では半球状) のはんだバンプ10が形 成される。

【0021】以上のようにはんだバンプ10が形成され た基板3上には、その後にチップ抵抗やチップコンデン サ等の表面実装部品 (図示略) が仮固定される。 この 際、ベアチップ実装領域R1 には、ベアチップ1が仮固 定される。そして、仮固定の後に再度リフローを行う と、図4、図5(d)に示されるように、はんだバンプ 10によってパッド4と外部接続端子2とが接合され る。即ち、基板3上にベアチップ1が表面実装された状 態となる。

【0022】本実施例のはんだバンプ10の形成方法 は、上記のようにマスク配置工程、印刷工程、マスク除 去工程及びリフロー工程からなるものであるため、電解 めっき法や無電解めっき法等のような化学プロセスとは 性質が異なる。即ち、はんだバンプ10を形成するとき でも、各工程において温度や時間等の条件を厳密に設定 する必要はない。ゆえに、所望形状のはんだバンプ10

ド用のパターンを引き回す必要がないため、基板3の大 型化や高コスト化も避けられる。さらに、組成が一定な クリームはんだ7を印刷してからリフローするという方 法であるため、はんだ合金の組成にばらつくが生じにく い。加えて、一回のスクリーン印刷によってクリームは んだ7を厚く転写することができるため、化学プロセス よりも確実に形成時間の短縮化を図ることができる。

【0023】また、本実施例の形成方法は、プリント配 線板を作製するときの既存の設備を使用すれば、容易に ェクション法とは異なり、溶融はんだ供給用のディスペ ンサ等も不要であるため、設備コストを抑えることがで きる。

〔実施例2〕次に、実施例2の形成方法を図6~図9に 基づいて説明する。本実施例では実施例1との相違点を 中心に説明することとし、共通点については同一番号を 付して説明を省略する。

【0024】実施例2では、まず実施例1に準じてマス ク配置工程及び印刷工程を行うことによって、図6 ,図 9 (a) に示されるように、各パッド4の上面にクリー 20 ムはんだ15を転写する。この場合、実施例1と同一の メタルマスク5が用いられる。ただし、この実施例で は、平均粒径が20μm~60μm程度のはんだ粉16 を含む通常のクリームはんだ15が使用される。

【0025】次のリフロー工程では、基板3にメタルマ スク5を重ね合わせたままの状態で基板3をリフロー炉 に移し、基板3をはんだ合金の溶融温度である183℃ に加熱する。すると、クリームはんだ15が溶融し、図 7, 図9 (b) に示されるように、溶融したはんだ15 aがパッド4の上面に凝集する。このとき、溶融したは 30 んだ15aの体積は、リフローの熱でベヒクル8が蒸発 することによって、当初の体積の約半分になる。その結 果、パッド4上に半球状のはんだバンプ10が形成され る。なお、開口部6の内壁面とはんだ15aの側面との 間には、ベヒクル8の蒸発に起因して僅かな隙間が生じ る。さらに、基板3を放冷した後、図8, 図9 (c) に 示されるように、不要となったメタルマスク5を基板3 から取り去る。

【0026】以上のようなはんだバンプ10の形成方法 であっても、実施例1と同様の作用効果を奏する。特 に、この形成方法であると、リフロー工程によって開口 部6-はんだ15a間に隙間が生じるため、基板3から メタルマスク5を容易に除去することができる。従っ て、特に版抜け性を向上させる対策を採る必要がなく、 通常のクリームはんだ15で足りるというメリットがあ る。また、本実施例において使用されるメタルマスクラ はステンレス製であるため、リフロー時の熱にも充分に 耐えうる。

〔実施例3〕次に、実施例3の形成方法を図10に基づ

中心に説明することとし、共通点については同一番号を 付して説明を省略する。

【0027】実施例3では、マスク配置工程、1回目の 印刷・リフロー工程、マスク除去工程、マスク配置工 程、2回目の印刷・リフロー工程及びマスク除去工程を 経ることによって、積層構造のはんだパンプ17が形成 される。なお、メタルマスク5を重ね合わせたままでリ フローを行う点については、実施例2と共通する。

【0028】まず、実施例1に準じてマスク配置工程及 実施することができる。さらに、従来のソルダーインジ 10 び第1の印刷工程を行うことによって、図10(a)に 示されるように、各パッド4の上面にクリームはんだ (即ち、Pb/Sn=90/10) 18を転写する。こ の場合、実施例1と同一のメタルマスク5が用いられ

> 【0029】第1のリフロー工程では、基板3にメタル マスク5を重ね合わせたままの状態で基板3をリフロー 炉に移し、基板3をはんだ合金の溶融温度に加熱する。 すると、クリームはんだ18が溶融し、図10(b)に 示されるように、 溶融したはんだ18aの凝集によっ て、パッド4上に半球状のはんだバンプ19が形成され る。さらに、基板3を放冷した後、不要となったメタル マスク5を基板3から取り去る。

> 【0030】第2回めのマスク配置工程では、前記メタ ルマスク5よりも肉厚な別のメタルマスク20を基板3 に重ね合わせる。このメタルマスク20には、メタルマ スク5と同じ位置に同一形状の開口部6が形成されてい る。そして、第2の印刷工程によって、図10(c)に 示されるように、はんだバンプ19の部分にクリームは んだ7を転写する。その結果、クリームはんだ7によっ てはんだバンプ19がほぼ被覆された状態となる。な お、この工程で使用されるクリームはんだ7の組成はP b/Sn=37/63であり、溶融温度は183℃であ る。即ち、第1の印刷・リフロー工程で使用されるクリ ームはんだ18は、第2の印刷・リフロー工程で使用さ れるクリームはんだ7よりも融点が高いことになる。

【0031】第2のリフロー工程では、基板3にメタル マスク20を重ね合わせたままの状態で基板3をリフロ 一炉に移し、基板3をはんだ合金の溶融温度である18 3℃に加熱する。すると、クリームはんだ7のみが溶融 し、図10(d)に示されるように、積層構造をした半 40 球状のはんだバンプ17が形成される。さらに、基板3 を放冷した後、不要となったメタルマスク20を基板3 から取り去る。

【0032】以上のようなはんだバンプ17の形成方法 であっても、実施例1,2と同様の作用効果を奏する。 特に、この形成方法では、第1の印刷・リフロー工程で 使用されるクリームはんだ18の融点を、第2の印刷・ リフロー工程で使用されるクリームはんだ7の融点より も相対的に高いものとしている。このため、下層側のは いて説明する。本実施例では実施例1,2との相違点を 50 んだバンプ19が第2の印刷・リフロー工程で加熱され

たとしても、同はんだバンプ19が溶融することはな い。つまり、このような積層構造を採ることが可能であ るため、背の高いはんだパンプ17を比較的容易に形成 することができる。そして、背の高いはんだバンプ17 であると、ベアチップ1との接続信頼性が向上し、接合 部分に働く応力にも強くなる。

【0033】なお、本発明は例えば次のように変更する ことが可能である。

(1)セラミックス製の基板3の代わりに、樹脂等から なる基板3を使用してもよい。

【0034】(2)実施例1~3において使用したクリ ームはんだ7、18とは異なる組成を有するPb/Sn 系のクリームはんだを使用することも可能である。ま た、Pb/Sn系のクリームはんだ7,18以外にも、 Au系、In系、Bi系等のクリームはんだを使用して もよい。さらに、実施例3において、Pb/Sn系のク リームはんだ7、18と、Pb/Sn系以外のクリーム はんだとを組み合わせて使用すことも可能である。

【0035】(3)図11に示される別例1のように、 裏面側に向かって拡がるテーパが設けられた開口部22 20 を有するメタルマスク21を使用して、はんだバンプ2 3の形成を行ってもよい。この方法であると、印刷後に おけるクリームはんだ7の版抜け性が向上する。

【0036】(4)図12に示される別例2のように、 開口部24,25の形状が異なる2種のメタルマスク2 6,27を組み合わせて使用すれば、実施例3よりも複 雑な形状をした積層構造のはんだバンプ28を形成する ことも可能である。

【0037】(5)メタルマスク5,20,26,27 ル等でもよい。ただし、実施例2,3等のようにメタル マスク5、20を重ね合わせたままでリフローを行う場 合には、基板に近い熱膨張率のものであることが好まし

【0038】(6)被実装物はベアチップ1のみに限定 されるわけではなく、例えばBGA、バットジョイント のPGA等といったプラスティックパッケージやセラミ ックパッケージでもよい。

【0039】(7)実施例2,3において、基板3が完 全に冷却する前にメタルマスク5、20を取り去る方法 40 す部分概略断面図である。 としてもよい。この方法であれば、形成時間の短縮化を 図ることができる。

【0040】(8)2種のメタルマスク5,20を使用 した実施例3において、いずれか1種のメタルマスク 5,20のみを使用することとしてもよい。同一のメタ ルマスク5,20を使用すれば、マスク剥離及び配置工 程が省略される分だけ、工程が簡略化する。

【0041】(9)実施例3において、クリームはんだ 7,18の印刷・リフロー工程を3回以上実施しても構 わない。

(10) 基板3上の導体部分は、スルーホールのランド や配線パターン等であっても勿論よい。

【0042】(11) 開口部6は必ずしもパッド4よ りも小さくなくてもよい。この場合、実施例2のように メタルマスク5を重ね合わせたままでリフローを行う と、得られるはんだバンプ10の形状が開口部6の内壁 面の形状に近いものとなる。つまり、ストレートウォー ル状のはんだバンプ10を得ることができる。

【0043】ここで、特許請求の範囲に記載された技術 10 的思想のほかに、前述した実施例及び別例によって把握 される技術的思想をその効果とともに以下に列挙する。

(1) 請求項3において、最後に行われる印刷・リフ ロー工程で使用されるクリームはんだを共晶はんだと し、それよりも先に行われる印刷・リフロー工程で使用 されるクリームはんだを、共晶はんだよりもPb含有率 が高いものとすること。

【0044】なお、本明細書中において使用した技術用 語を次のように定義する。

「リフロー: 基板を所定温度に加熱することによっ て、印刷されたクリームはんだを溶融させることをい う。」

[0045]

【発明の効果】以上詳述したように、請求項1~3に記 載の発明によれば、所望形状のバンプを安価にかつ容易 に形成することができるバンプの形成方法を提供するこ とができる。特に請求項2に記載の発明によれば、リフ ロー後にメタルマスクを取り去る方法であるため、バン プをより容易に形成することができる。また、請求項3 に記載の発明によれば、積層構造を採ることができるた の形成材料は、ステンレス以外にも、りん青銅、ニッケ 30 め、背の高いバンプを比較的容易に形成することができ

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1のバンプの形成方法を示す部分概略斜 視図である。

【図2】同じく部分機略斜視図である。

【図3】同じく部分概略斜視図である。

【図4】ベアチップが実装された基板を示す部分概略斜 視図である。

【図5】同じく(a)~(d)はバンプの形成方法を示

【図6】実施例2のバンプの形成方法を示す部分概略斜 視図である.

【図7】同じく部分概略斜視図である。

【図8】同じく部分概略斜視図である。

【図9】同じく(a)~(c)はバンプの形成方法を示 す部分概略断面図である。

【図10】(a)~(d)は実施例3のバンプの形成方 法を示す部分機略断面図である。

【図11】(a), (b)は別例1のバンプの形成方法 50 を示す部分概略断面図である。

9

【図12】(a)~(d)は別例2のバンプの形成方法 を示す部分概略断面図である。

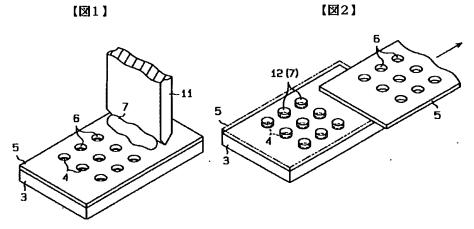
【符号の説明】

3…基板、4…導体部分としてのパッド、5,20,2

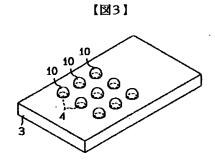
6,27…メタルマスク、6,24,25…開口部、 7, 15, 18…クリームはんだ、9, 16…はんだ 粉、10, 17, 23, 28…バンプとしてのはんだバ ンプ。

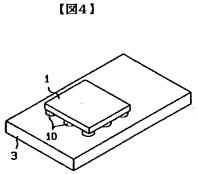
10

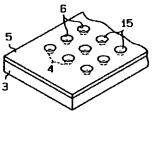
【図1】



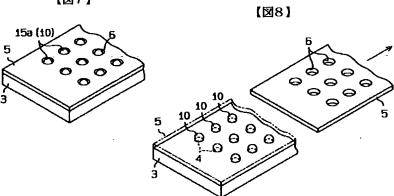
【図6】

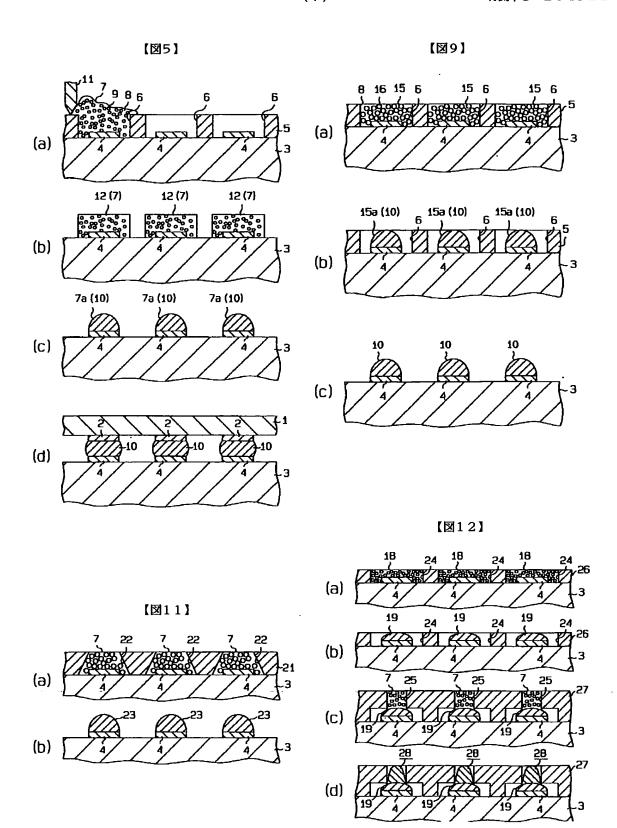




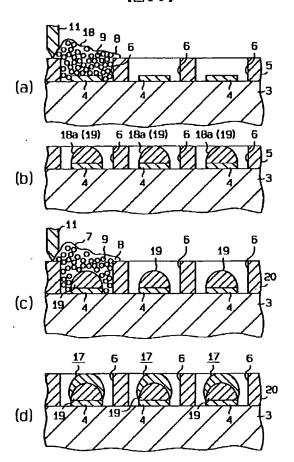


【図7】





【図10】



Generate Collection

L3: Entry 72 of 95

File: JPAB

Aug 9, 1996

PUB-NO: JP408204322A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08204322 A TITLE: FORMING METHOD FOR BUMP

PUBN-DATE: August 9, 1996

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

WAKIHARA, YOSHINORI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

IBIDEN CO LTD

APPL-NO: JP07010927

APPL-DATE: January 26, 1995

INT-CL (IPC): $\underline{H05}$ \underline{K} $\underline{3/34}$; $\underline{H05}$ \underline{K} $\underline{3/34}$; $\underline{H05}$ \underline{K} $\underline{3/34}$

ABSTRACT:

PURPOSE: To easily form a low-cost <u>bump of a desired shape</u> by printing cream solder containing solder powder having a mean particle size of <u>specific</u> value or less on a metal <u>mask</u> superposed on a board, removing the <u>mask</u> from the board, and then melting the solder.

CONSTITUTION: A metal mask 5 is first superposed on the surface of a board 3, and the position of an opening 6 is brought into coincidence with that of a pad 4. Then, cream solder 7 containing solder powder having mean particle size of 20μm or less is printed on the mask 5. Thereafter, when the mask 5 is steadily removed from the board 3, the solder 7 is removed from a printing plate via the opening 6 of the mask 5, and a transfer pattern 12 remains on the board 3. Then, when the board 3 is heated to a predetermined temperature, the solder 7 is melted, and the solder 7a becomes a bump 10 of desired shape. The pad 4 is connected to an external terminal 2 by the bump 10. That is, a bare chip 1 is surface mounted on the board 3.

COPYRIGHT: (C) 1996, JPO